

第三届新型半导体功率器件及应用技术研讨会在长沙成功召开

继在厦门、昆明成功举办两届研讨会之后，“第三届新型半导体功率器件及应用技术研讨会”于2017年11月24-27日在长沙成功召开。此次研讨会由中国半导体行业协会指导，中国半导体行业半导体分立器件分会和株洲中车时代电气股份有限公司主办。中国半导体行业副理事长陈贤和半导体分立器件分会理事长杨克武分别致辞，欢迎来自全国各地的代表共同参与此次研讨。中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼总工程师冯江华也代表主办方致辞，就株洲中车时代整体状况与发展水平做了介绍。随后，特邀专家做了精彩的主旨报告，就当前功率器件领域的最新技术、发展状况及产业规模与代表们分享，分别是刘国友的《后IGBT时代的技术研发与产业化战略思考》、李泽宏的《集成功率器件与隔离技术的进展》、罗海辉的《汽车IGBT芯片研发及其封装解决方案》、冯志红的《氮化镓毫米波器件进展》、和巍巍的《碳化硅电力电子器件技术及应用》、陈子颖的《SiC MOSFET——技术、器件和应用》和裴轶的《氮化镓功率电子器件及其应用》。大会期间，有40余位代表携最新研发成果到会交流。

研讨会虽时间短暂，但与会代表却收获颇丰。2018年，我们将带来更新的半导体功率器件研发成果，期待与您再次相聚！



陈贤副理事长致辞



分立器件分会理事长杨克武致欢迎辞



冯江华总工致辞



研讨会会场